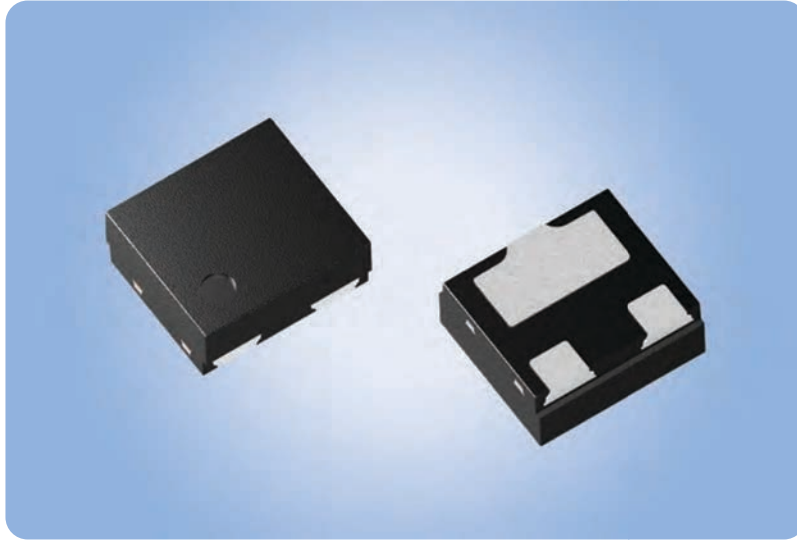


采用节省空间的 DFN1110-3A 封装的 双向对称双列超低电容ESD 保护二极管



主要优势

- 超低负载电容，典型值低至 0.37 pF
- 紧凑 DFN1110-3A 封装，带有可润湿侧翼
- 工作电压为 ± 5.5 V 时，最大漏电电流低至 < 0.1 μ A
- 1 mA 时击穿电压典型值为 8.5 V
- 3.4 A 时最大钳位电压为 18 V
- 支持汽车系统的自动光学检测 (AOI)
- 根据 IEC 61000-4-2 标准在 ± 20 kV（空气和接触放电）下为数据线提供瞬态保护
- 提供通过 AEC-Q101 认证的版本
- 符合 RoHS 标准，不含卤素，并且是 [Vishay 绿色产品](#)

应用

- 接口保护，包括商业和汽车应用中的 USB 2.0、USB 3.0 和 HDMI

RESOURCES

- 数据表: [VBUS05M2-HT5](#)
- 如有技术问题，请联系 ESDProtection@vishay.com
- 材料分类：有关合规性的定义，请参见 www.vishay.com/doc?99912

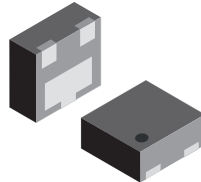


RoHS
COMPLIANT

HALOGEN
FREE

GREEN
(5-2008)

采用节省空间的 DFN1110-3A 封装的 双向对称双列超低电容ESD 保护二极管



DFN1110-3A

标记（仅为示例）



圆点 = 引脚标记

X = 日期代码

Y = 类型代码（见下表）

链接至其他资源



3D 模型

特性

- 小型 DFN1110-3A
- 双列 ESD 保护
- 工作范围为 $\pm 5.5\text{ V}$
- 低漏电流 $I_R < 0.05\text{ }\mu\text{A}$
- 低负载电容 $C_D < 0.45\text{ pF}$
- ESD 抗扰度，符合 IEC61000-4-2 标准
 $\pm 20\text{ kV}$ 接触放电
 $\pm 20\text{ kV}$ 空气放电
- 符合 AEC-Q101 标准的 ESD 能力：
人体模型：H3B 级： $> 8\text{ kV}$
- e3 - 引脚侧壁镀锡 (Sn)
- 具有 AOI 功能
- 提供通过 AEC-Q101 认证的版本
- 材料分类：有关合规性的定义，请参见
www.vishay.com/doc?99912



RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE
GREEN
(5-2008)

ORDERING INFORMATION

PART NUMBER (EXAMPLE)	ENVIRONMENTAL AND QUALITY CODE			PACKAGING CODE	ORDERING CODE (EXAMPLE)
	AEC-Q101 QUALIFIED	RoHS-COMPLIANT + LEAD (Pb)-FREE TERMINATIONS	TIN PLATED	10K PER 7" REEL (8 mm TAPE) 10K/BOX = MOQ	
		GREEN			
VBUS05M2-HT5	-	G	3	-08	VBUS05M2-HT5-G3-08
VBUS05M2-HT5	H	G	3	-08	VBUS05M2-HT5HG3-08

PACKAGE DATA

DEVICE NAME	PACKAGE NAME	TYPE CODE	WEIGHT	MOLDING COMPOUND FLAMMABILITY RATING	MOISTURE SENSITIVITY LEVEL	SOLDERING CONDITIONS
VBUS05M2-HT5	DFN1110-3A	M	1.43 mg	UL 94 V-0	MSL level 1 (according J-STD-020)	Peak temperature max. 260 °C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	TEST CONDITIONS	SYMBOL	VALUE	UNIT
Peak pulse current	Acc. IEC 61000-4-5; $t_P = 8/20\text{ }\mu\text{s}$; single shot	I_{PPM}	3.4	A
Peak pulse power	Acc. IEC 61000-4-5; $t_P = 8/20\text{ }\mu\text{s}$; single shot	P_{PP}	60	W
ESD immunity	Contact discharge acc. IEC 61000-4-2; 10 pulses	V_{ESD}	± 20	kV
	Air discharge acc. IEC 61000-4-2; 10 pulses		± 20	
Operating temperature	Junction temperature	T_J	-55 to +150	°C
Storage temperature		T_{STG}	-55 to +150	°C

版本：2020 年 9 月 02 日